

プレISGN-2シンポジウム「未来を切り開く窒化物半導体結晶」

主催 : ISGN-2 実行・プログラム委員会、日本結晶成長学会ナノ構造・エピタキシャル成長分科会、
東京農工大学大学院ナノ未来科学研究拠点

共催 : 文部科学省 科学研究費 特定領域研究「窒化物光半導体のフロンティア -材料潜在能力の極限発現-」
大阪大学グローバルCOE「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

協賛 : 日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第162委員会

12月19日(水)
東京・田町キャンパスイノベーションセンター 1階 国際会議場
時間(分)

Plenary講演(講演30+質疑10)
招待講演(講演23+質疑7)

座長

10:00 ~ 10:10	10	はじめに	(東京農工大・工) 瀬瀬明伯	天野
10:10 ~ 10:50	40	「高出力高周波GaN HFETの現状と課題」 -結晶品質はどこまで求められるか-	(立命館大・理工) 名西愷之	
10:50 ~ 11:20	30	R面サファイア上へのA面GaN成長における成長温度・圧力効果	(三重大・工) 三宅秀人、宮川鈴衣奈、生川満久、平松和政	
11:30 ~ 12:55		昼食		
13:00 ~ 13:30	30	窒化物半導体結晶の室温成長技術	(東大・生産研, 神奈川科学技術アカデミー) 藤岡 洋	三宅
13:30 ~ 14:00	30	「MBEによるInNの高品質エピタキシャル成長制御と物性制御」—“1分子層”InNナノ構造制御とその光デバイス応用について—	(千葉大・工) 崔 成伯、王 新強、橋本直樹、斎藤英幸、藤本哲爾、大森祐治、石谷善博、吉川明彦	
14:00 ~ 14:30	30	HVPEによるInN成長と表面反応メカニズム	(東京農工大・工) 熊谷義直、瀬瀬明伯	
14:30 ~ 14:50		休憩		
14:50 ~ 15:20	30	NaフラックスLPE法による大型GaN結晶育成技術	(大阪大・工) 森 勇介	瀬瀬
15:20 ~ 15:50	30	ダイヤモンド、SiC基板上へのAlNのMOVPE成長	(NTT物性研) 谷保芳孝、嘉数 誠	
15:50 ~ 16:30	40	Ⅲ族窒化物半導体混晶のエピタキシャルラテラルオーバーグロース	(名城大・理工) 天野 浩、飯田一喜、岡田成仁、川島毅士、飯田大輔、三浦 彩、千田亮太、岩谷素顕、上山 智、赤崎 勇	